

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 12 日 (2006.1.12)

【公開番号】特開 2001-281849 (P2001-281849A)

【公開日】平成 13 年 10 月 10 日 (2001.10.10)

【出願番号】特願 2000-371650 (P2000-371650)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

C 0 8 K 5/00 (2006.01)

C 0 8 L 101/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/004 5 0 3 A

G 0 3 F 7/004 5 0 1

C 0 8 K 5/00

C 0 8 L 101/02

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 11 月 21 日 (2005.11.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (A) 酸の作用により分解し、アルカリ現像液中での溶解度を増大させる基を有する樹脂、及び

(B) 活性光線または放射線の照射により、少なくとも 1 つのフッ素原子で置換された脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【請求項 2】 (D) 酸の作用により分解し、アルカリ現像液への溶解性が増大する分子量 3 0 0 0 以下の化合物をさらに含有することを特徴とする請求項 1 に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 3】 (B) 活性光線または放射線の照射により、少なくとも 1 つのフッ素原子で置換された脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸を発生する化合物、

(D) 酸の作用により分解し、アルカリ現像液への溶解性が増大する分子量 3 0 0 0 以下の化合物、及び

(E) アルカリ可溶性樹脂を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【請求項 4】 (C) 活性光線または放射線の照射によりスルホン酸を発生する化合物をさらに含有することを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 5】 (F) 含窒素塩基性化合物、及び、(G) フッ素系またはシリコン系界面活性剤をさらに含有することを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 6】 請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。